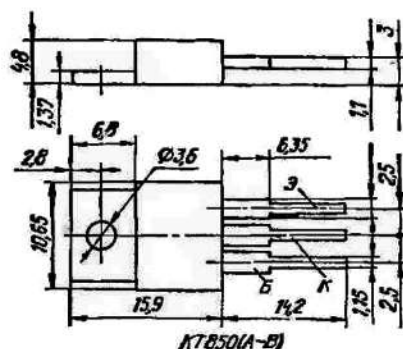


КТ850А, КТ850Б, КТ850В

Кремниевые планарные транзисторы *n-p-n*. Предназначены для применения в усилителях мощности, переключающих устройствах.

Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами.

Эксплуатируются при $\theta_{\text{всп}}$ от -60 до $+100$ °С.
 Масса транзистора не более 2,5 г.



Эксплуатационные параметры и предельные значения допустимых режимов работы

Обозначение	Режим измерения	КТ850А	КТ850Б	КТ850В
I_{21E}	$U_{КЭ}=10$ В; $I_{К}=0,5$ А	40...200	≥ 20	≥ 20
$I_{КЭ0}$, мА	$U_{КБ}=U_{КБ, \text{max}}$	$\leq 0,1$	$\leq 0,5$	$\leq 0,5$
$I_{ЭБ0}$, мА	$U_{БЭ}=5$ В	$\leq 0,1$	$\leq 0,5$	$\leq 0,5$
$U_{КЭ, \text{гр}}$, В	$I_{Э}=30$ мА	200	250	150
$U_{КЭ, \text{нас}}$, В	$I_{К}=0,5$ А; $I_{Б}=0,1$ А	≤ 1	≤ 1	≤ 1
$U_{БЭ, \text{нас}}$, В	$I_{К}=0,5$ А; $I_{Б}=-0,1$ А	$\leq 1,6$	$\leq 1,6$	$\leq 1,6$
$U_{КБ, \text{max}}$, В	$R_{БЭ} \leq 1$ кОм; $(d \cdot U_{КЭ}/dt) \leq 250$ В/мкс	200	250	150
$U_{КБ, \text{max}}$, В	$(d \cdot U_{КБ}/dt) \leq 250$ В/мкс	250	300	180
$U_{БЭ, \text{max}}$, В		5	5	5
$I_{К, \text{max}}$, А		2	2	2
$I_{К, \text{н. max}}$, А	$t_n \leq 2$ мкс; $Q \geq 2$	3	3	3
$I_{Б, \text{max}}$, В		0,5	0,5	0,5
$P_{К, \text{max}}$, Вт		25	25	25
$\theta_{\text{всп}}$, °С	$\theta_{К} = -60 \dots +25$ °С	150	150	150